

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

直線偏光を照射する光照射手段と、
入射した光によって励起されるアルカリ金属原子が充填されるガスセルと、
前記光照射手段と前記ガスセルとの間の光軸上に配置され、入射した前記直線偏光をプローブ光と参照光とに分岐する第1光学手段と、
入射した光の強度を検出する第1検出部及び第2検出部と、
前記ガスセルを透過した前記プローブ光が入射する第1面と、前記参照光が入射する第2面とを有する第2光学手段と、
前記第2光学手段の前記第2面に入射する前記参照光の強度を、前記ガスセルを透過した後の前記プローブ光の強度と同等とする第3光学手段と、を備え、
前記第2光学手段は、前記第1面に入射した前記プローブ光を前記第1検出部と前記第2検出部とに分岐して入射させると共に、前記第2面から入射した前記参照光を前記第1検出部と前記第2検出部とに分岐して入射させることを特徴とする磁場計測装置。
10

【請求項 2】

前記ガスセルを透過した前記プローブ光を反射して再び前記ガスセルに入射させるミラーをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の磁場計測装置。

【請求項 3】

前記プローブ光が前記ガスセルを1回透過した後に、前記第1面に入射するように、前記ガスセルに対して前記第2光学手段が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の磁場計測装置。
20

【請求項 4】

前記第3光学手段を透過した後の前記参照光を反射して前記第2光学手段の前記第2面に導くミラーをさらに備えたことを特徴とする請求項3に記載の磁場計測装置。

【請求項 5】

前記第1光学手段は、無偏光ビームスプリッターであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の磁場計測装置。

【請求項 6】

前記第2光学手段は、偏光ビームスプリッターであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の磁場計測装置。
30

【請求項 7】

前記第3光学手段は、光の透過率を変更可能な光学フィルターであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の磁場計測装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、磁場計測装置に関する。

【背景技術】

【0002】

上記磁場計測装置として、微小な磁場を測定可能な光ポンピング磁力計が開示されている（特許文献1）。

【0003】

上記特許文献1の光ポンピング磁力計は、セル内に封入されたガス状態の原子群に、ポンプ光を照射して原子群を構成する原子のスピンの向きを揃える。原子のスピンの向きが揃った原子群にプローブ光としての直線偏光を照射する。測定対象としての例えは人体から発せられる磁場の強度によって上記原子のスピンの向きが変化する。照射された直線偏光は上記原子のスピンの影響を受けて偏光回転角が変化することから、偏光回転角を検出することによって、当該磁場の強度を測定可能としたものである。

【0004】

上記特許文献1の光ポンピング磁力計では、セル内を透過してきた後のプローブ光を反

10

20

30

40

50

射させる少なくとも 1 つの反射ミラーを備え、セルを少なくとも 2 回以上横断してきたプローブ光の偏光回転角度を検出することから、高感度な磁場検出が可能であるとしている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特開 2009-236599 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上記特許文献 1 の光ポンピング磁力計は、高感度であるがゆえに、磁場の測定を阻害するノイズを取り除く必要がある。当該ノイズとして、地磁気などの外部磁気ノイズが挙げられる。

【0007】

上記光ポンピング磁力計では、外部磁気ノイズの影響を低減するために、磁気シールド内にセルを配置すると共に、磁気シールド内部の残留磁気を打ち消すためのヘルムホルツコイルを備えている。

【0008】

しかしながら、当該ノイズとして、外部磁気ノイズの他に、プローブ光が放出された空間における空気の振動などによる直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズが挙げられる。

上記光ポンピング磁力計では、該光学ノイズに対する対策が施されていないという課題があった。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態または適用例として実現することが可能である。

【0010】

[適用例] 本適用例に係る磁場計測装置は、直線偏光を照射する光照射手段と、入射した光によって励起されるアルカリ金属原子が充填されるガスセルと、前記光照射手段と前記ガスセルとの間の光軸上に配置され、入射した前記直線偏光をプローブ光と参照光とに分岐する第 1 光学手段と、入射した光の強度を検出する第 1 検出部及び第 2 検出部と、前記ガスセルを透過した前記プローブ光が入射する第 1 面と、前記参照光が入射する第 2 面とを有する第 2 光学手段と、前記第 2 光学手段の前記第 2 面に入射する前記参照光の強度を、前記ガスセルを透過した後の前記プローブ光の強度と同等とする第 3 光学手段と、を備え、前記第 2 光学手段は、前記第 1 面に入射した前記プローブ光を前記第 1 検出部と前記第 2 検出部とに分岐して入射させると共に、前記第 2 面から入射した前記参照光を前記第 1 検出部と前記第 2 検出部とに分岐して入射させることを特徴とする。

【0011】

本適用例によれば、第 3 光学手段により、ガスセルを透過したプローブ光の強度と参照光の強度とを同等とする。そして、強度が同等となった参照光を第 2 光学手段により第 1 検出部と第 2 検出部とに分岐して入射させる。第 1 検出部と第 2 検出部とには、第 2 光学手段により分岐されたプローブ光と参照光とがそれぞれ入射することから、プローブ光に含まれる直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズを参照光によって打ち消すことができる。つまり、プローブ光に含まれる直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズを低減して、精度よく磁場測定が可能な磁場計測装置を提供することができる。

【0012】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記ガスセルを透過した前記プローブ光を反射して再び前記ガスセルに入射させるミラーをさらに備えることが好ましい。

この構成によれば、プローブ光はミラーによって反射して少なくとも 2 回ガスセルを透過することになるので、高感度な磁場計測装置を提供することができる。また、ミラーを

10

20

30

40

50

非磁性とすれば、磁場源とガスセルとの間にミラーを配置しても、磁場源の磁場計測に影響を及ぼさない。

【0013】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記プローブ光が前記ガスセルを1回透過した後に、前記第1面に入射するように、前記ガスセルに対して前記第2光学手段が配置されているとしてもよい。

この構成によれば、光照射手段、第1光学手段、ガスセル、第2光学手段を同一の光学軸上において直線的に配置することができるため、ガスセルを含めた各手段の相対的な位置を容易に位置決めすることができる。言い換えれば、装置構成を簡素化することが可能である。

10

【0014】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記第3光学手段を透過した後の前記参照光を反射して前記第2光学手段の前記第2面に導くミラーをさらに備えたことを特徴とする。

この構成によれば、同一の光学軸上において、ガスセルを挟んで第1光学手段と第2光学手段とを離間させて配置しても、ミラーによって参照光を反射させて第2光学手段の第2面に導くことができる。言い換えれば、同一の光学軸上における第1光学手段と第2光学手段との位置決めを容易とすることができます。

【0015】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記第1光学手段は、無偏光ビームスプリッターであることが好ましい。

20

この構成によれば、無偏光ビームスプリッターによって入射した直線偏光をプローブ光と参照光とにそれぞれ同じ強度で分岐することができる。

【0016】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記第2光学手段は、偏光ビームスプリッターであることが好ましい。

この構成によれば、偏光ビームスプリッターの第1面に入射した直線偏光であるプローブ光を第1検出部と第2検出部とに分岐して入射させると共に、第1面に隣り合う第2面に入射した同じく直線偏光である参照光を第1検出部と第2検出部とに分岐して入射させることができる。

30

【0017】

上記適用例に記載の磁場計測装置において、前記第3光学手段は、光の透過率を変更可能な光学フィルターであることが好ましい。

この構成によれば、光学フィルターに入射した参照光の強度を、ガスセルを透過した後のプローブ光の強度と同等となるように調整して透過させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】第1実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図。

【図2】原子スピンのアライメント状態を示す図。

【図3】直線偏光の偏光面の回転を示す図。

40

【図4】第2実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図。

【図5】第3実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図。

【図6】変形例の磁場計測装置の構成を示す概略図。

【発明を実施するための形態】

【0019】

以下、本発明を具体化した実施形態について図面に従って説明する。なお、使用する図面は、説明する部分が認識可能な状態となるように、適宜拡大または縮小して表示している。

【0020】

(第1実施形態)

50

<磁場計測装置>

本実施形態の光ポンピング方式の磁場計測装置について、図1を参照して説明する。図1は第1実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図である。

図1に示すように、本実施形態の磁場計測装置100は、直線偏光を照射する光照射手段としてのレーザー光照射装置101と、ガスセル102と、第1光学手段としての無偏光ビームスプリッター103と、第2光学手段としての偏光ビームスプリッター104と、第3光学手段としての光学フィルター105と、入射した光の強度を検出する第1検出部としてのフォトディテクタ(PD)106と、同じく入射した光の強度を検出する第2検出部としてのフォトディテクタ(PD)107と、ミラー108と、を備えている。磁場源M1は、例えば人体のうち脳や心臓などの臓器であって、ミラー108を挟んでガスセル102の近傍に配置される。

10

【0021】

ガスセル102は、光を透過可能な透明な例えはガラスなどの容器であって、入射した光によって励起(ポンピング)されるアルカリ金属原子がガスセル102の内部に気体の状態で封入されている。アルカリ金属原子としては、カリウム(K)、セシウム(Cs)、ルビジウム(Rb)などが挙げられ、本実施形態では、他のアルカリ金属原子よりも融点が低く、融点があよそ29のセシウムが用いられている。なお、図1ではガスセル102の形状を球状として表したが、ガスセル102の形状はこれに限定されるものでなく、例えば直方体であってもよい。

【0022】

レーザー光照射装置101は、アルカリ金属原子(セシウム)を励起可能な波長範囲の直線偏光であるレーザー光Lをガスセル102に向かって照射可能となっている。具体的には、アルカリ金属原子におけるD1線の超微細構造量子数FがF-1=F'の状態に遷移するように、レーザー光Lを調整する。

20

【0023】

レーザー光照射装置101とガスセル102との間の光軸上に配置された無偏光ビームスプリッター103は、例えは2つの直角プリズムが接合されたものであって、入射したレーザー光Lをプローブ光Lpと参照光Lrとに分岐するプリズム界面103aを有している。プリズム界面103aには、例えは屈折率が異なる誘電体膜が積層された誘電体多層膜が形成されており、プリズム界面103aに入射して誘電体多層膜を透過した光がプローブ光Lpとなり、プリズム界面103aに入射して誘電体多層膜により反射した光が参照光Lrとなる。無偏光ビームスプリッター103において、透過光であるプローブ光Lpの強度、及び反射光である参照光Lrの強度は、入射光であるレーザー光Lの強度に対して半分となっている。言い換えれば、入射したレーザー光Lの強度に対して、プローブ光Lp及び参照光Lrの強度がレーザー光Lの波長範囲においてそれぞれ半分となるように、プリズム界面103aに誘電体多層膜が形成されている。プリズム界面103aに形成される光学的な膜は、誘電体多層膜に限定されず、光透過性及び光反射性を兼ね備えた金属膜や、誘電体多層膜と該金属膜とが組み合わされたものであってもよい。

30

【0024】

プローブ光Lpは、ガスセル102に入射して透過し、ガスセル102と磁場源M1との間に配置されたミラー108によって反射され、再びガスセル102に入射する。ミラー108は、例えは、アルミニウム(Al)や銀(Ag)、あるいはこれらの合金などの非磁性金属材料からなる。ミラー108が非磁性であることから、ガスセル102と磁場源M1との間にミラー108が配置されても、磁場源M1の磁場計測に影響を及ぼさない。

40

【0025】

ミラー108で反射して再びガスセル102を透過したプローブ光Lpは偏光ビームスプリッター104に入射する。偏光ビームスプリッター104は、例えは2つの直角プリズムが接合されたものであって、プローブ光Lpが入射する第1面104aと、第1面104aに隣り合い、参照光Lrが入射する第2面104bと、直角プリズム同士の接合面

50

であるプリズム界面 104c とを有している。プリズム界面 104c には、入射した直線偏光を後述する p 波と s 波とに分離する分離膜が設けられている。該分離膜は、例えば屈折率が異なる誘電体多層膜や、誘電体多層膜と光透過性及び光反射性を兼ね備えた金属膜とを組み合わせたものが挙げられる。

【0026】

直線偏光であるプローブ光 Lp が、第1面 104a からプリズム界面 104c に所定の偏光面方向で入射するように、ガスセル 102 に対して偏光ビームスプリッター 104 が配置されている。偏光ビームスプリッター 104 に入射したプローブ光 Lp は、偏光ビームスプリッター 104 を透過する p 波 (p 偏光成分) と、プリズム界面 104c で反射する s 波 (s 偏光成分) とに分岐する。p 波及び s 波も直線偏光であって、p 波の直線偏光面は、プリズム界面 104c の入射面と平行となっている。s 波の直線偏光面は、p 波の直線偏光面と直交している。

10

【0027】

同じく直線偏光である参照光 Lr が、第2面 104b からプリズム界面 104c に所定の偏光面方向で入射するように、偏光ビームスプリッター 104 に対して無偏光ビームスプリッター 103 が配置されている。偏光ビームスプリッター 104 に入射した参照光 Lr もまた、偏光ビームスプリッター 104 を透過する p 波と、プリズム界面 104c で反射する s 波とに分岐する。

【0028】

以降の説明のため、偏光ビームスプリッター 104 によって分岐されたプローブ光 Lp の p 波を p₁ 波と呼び、s 波を s₁ 波と呼ぶ。また、偏光ビームスプリッター 104 によって分岐された参照光 Lr の p 波を p₂ 波と呼び、s 波を s₂ 波と呼ぶ。

20

【0029】

偏光ビームスプリッター 104 に対して、p₁ 波と s₂ 波とが入射する位置に PD106 が配置される。また、偏光ビームスプリッター 104 に対して、p₂ 波と s₁ 波とが入射する位置に PD107 が配置される。つまり、PD106 には、偏光ビームスプリッター 104 におけるプローブ光 Lp の透過光である p₁ 波と、偏光ビームスプリッター 104 における参照光 Lr の反射光である s₂ 波とが入射する。PD107 には、偏光ビームスプリッター 104 における参照光 Lr の透過光である p₂ 波と、偏光ビームスプリッター 104 におけるプローブ光 Lp の反射光である s₁ 波とが入射する。

30

【0030】

ガスセル 102 を透過してミラー 108 で反射し再びガスセル 102 を透過したプローブ光 Lp の強度は、ガスセル 102 を少なくとも 2 回透過することにより、無偏光ビームスプリッター 103 を透過した時点に比べて低下する。それゆえに、本実施形態では、偏光ビームスプリッター 104 の第1面 104a に入射するプローブ光 Lp の強度 W₁ と、偏光ビームスプリッター 104 の第2面 104b に入射する参照光 Lr の強度 W₂ とが同等となるように、無偏光ビームスプリッター 103 の参照光 Lr の射出側と、偏光ビームスプリッター 104 の第2面 104b との間に、参照光 Lr の強度を低下させる光学フィルター 105 が設けられている。

40

【0031】

光学フィルター 105 としては、例えば ND (Neutral Density) フィルター (減光フィルター) などを挙げることができる。

【0032】

無偏光ビームスプリッター 103 を配置して参照光 Lr を発生させる点と、発生させた参照光 Lr の強度を低下させる光学フィルター 105 を設ける点とについての技術的な説明については後述する。

【0033】

本実施形態の磁場計測装置 100 は、上述したように、光ポンピング方式の磁場計測装置であって、プローブ光 Lp が、ガスセル 102 に封入されたアルカリ金属原子を励起させるポンプ光を兼ねるものである。

50

【0034】

また、ミラー108を設けることにより、プローブ光Lpが少なくとも2回ガスセル102を透過するため、ミラー108を設けない場合（後述する第2実施形態にて説明）に比べて、高感度な磁場計測装置100を実現できる。

【0035】

なお、図1には図示していないが、磁場計測装置100は、レーザー光照射装置101とガスセル102との間のレーザー光Lの光軸上に、第1光学手段の一例である無偏光ビームスプリッター103を適正な位置に配置するための第1位置決め手段と、ガスセル102とPDL106との間のプローブ光Lpの光軸上に第2光学手段の一例である偏光ビームスプリッター104を適正な位置に配置するための第2位置決め手段とを備えることが好ましい。10

【0036】

<磁場測定の原理>

本実施形態の磁場測定の原理について、図1～図3を参照して説明する。図2は原子スピニのアライメント状態を示す図、図3は直線偏光の偏光面の回転を示す図である。

【0037】

図1のレーザー光照射装置101と無偏光ビームスプリッター103との間の光軸に沿った方向から見て、図2に示すように偏光面が45度（ $\pi/4$ ラジアン）回転した状態で直線偏光が照射されるようにレーザー光照射装置101が設置される。これにより、無偏光ビームスプリッター103によって分岐されたプローブ光Lpの偏光面もまた光軸に沿った方向から見て45度回転した状態でガスセル102に入射する。20

【0038】

ガスセル102に封入されたガス状のアルカリ金属原子は、ポンプ光を兼ねるプローブ光Lpが照射されることにより励起され、原子スピニがほぼ反平行（逆方向）に向いたアルカリ金属原子がほぼ同数混在する状態となる。この状態はアライメントと呼ばれ、原子スピニは、図2に示すように一方の端が連結された2つの橢円に似た形状となる。図1において磁場源M1がない、すなわち磁場が印加されない場合は、図2に示すように、直線偏光であるプローブ光Lpの振動方向と、原子スピニのアライメント方位とが一致する。

【0039】

上述したように、ガスセル102を透過したプローブ光Lpは、偏光ビームスプリッタ104によって p_1 波と s_1 波とに分岐される。プローブ光Lpの強度をA、 p_1 波の振幅をP、 s_1 波の振幅をS、さらに s_1 波の強度 S^2 と p_1 波の強度 P^2 との差をVとするとき、磁場が印加されないゼロ磁場の場合、プローブ光Lpの偏光面が回転しないことから、このときのP、S、Vは、以下の数式(1)～数式(3)で示される。30

【0040】

【数1】

$$P = A \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = A \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots \quad (1)$$

40

【0041】

【数2】

$$S = A \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = A \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots \quad (2)$$

【0042】

【数3】

$$V = S^2 - P^2 = 0 \dots \quad (3)$$

つまり、磁場が印加されない場合、 s_1 波の強度 S^2 と、 p_1 波の強度 P^2 との差 V は、「0」となる。

【0043】

次に、磁場源M1が配置され、ガスセル102に磁場が印加されると、ガスセル102中のアルカリ金属原子の原子スピンが磁場の影響を受け、磁場方向を回転軸として回転する歳差運動を始めることからアライメント方位が変化する。このとき、原子スピンのアライメント方位は、プローブ光 L_p の光ポンピングの作用と、光ポンピングの緩和の作用とが働いて方位が一定な定常状態となる。ガスセル102に入射した直線偏光であるプローブ光 L_p は、原子スピンのアライメントの影響を受け、印加された磁場の強度に応じて偏光面が回転してガスセル102から射出される。

10

【0044】

例えば、図3に示すように、プローブ光 L_p の偏光面（図3に破線で示した）の角度が、45度から反時計回りに+（反時計回りを「+」とする）回転した場合（図3で実線で示した）を想定すると、このときの P 、 S は以下の数式(4)、数式(5)によって導かれる。

20

【0045】

【数4】

$$P = A \cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \dots \quad (4)$$

【0046】

【数5】

$$S = A \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \dots \quad (5)$$

30

【0047】

数式(4)を展開すれば以下の数式(6)となり、数式(5)を展開すれば以下の数式(7)となる。

【0048】

【数6】

$$P = A \cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = A \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} A (\cos \theta - \sin \theta) \dots \quad (6)$$

40

【0049】

【数7】

$$S = A \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = A \left(\sin \frac{\pi}{4} \cos \theta + \cos \frac{\pi}{4} \sin \theta \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} A (\cos \theta + \sin \theta) \dots \quad (7)$$

【0050】

したがって、このときの V は以下の数式(8)で示される。

【0051】

【数8】

$$\begin{aligned}
 V = S^2 - P^2 &= \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} A (\cos\theta + \sin\theta) \right\}^2 - \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} A (\cos\theta - \sin\theta) \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{2} A^2 (\cos\theta + \sin\theta)^2 - \frac{1}{2} A^2 (\cos\theta - \sin\theta)^2 \\
 &= \frac{1}{2} A^2 \left\{ (\cos^2\theta + 2\cos\theta \sin\theta + \sin^2\theta) \right. \\
 &\quad \left. - (\cos^2\theta - 2\cos\theta \sin\theta + \sin^2\theta) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} A^2 (4\cos\theta \sin\theta) \\
 &= 2A^2 (\cos\theta \sin\theta) \\
 &= A^2 \sin 2\theta
 \end{aligned}
 \quad \left. \cdots \quad (8) \right\}^{10}$$

【0052】

20

次に、上記のように、プローブ光 L_p の偏光面が + 回転した場合に対して、印加される磁場の向きが逆方向になると、プローブ光 L_p の偏光面は時計回りに - 回転することになる。よって、このときの P , S , V は以下の数式 (9) ~ 数式 (11) で示される。

【0053】

【数9】

$$P = A \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \quad \cdots \quad (9)$$

【0054】

30

【数10】

$$S = A \sin\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \quad \cdots \quad (10)$$

【0055】

【数11】

$$V = S^2 - P^2 = -A^2 \sin 2\theta \quad \cdots \quad (11)$$

40

つまり、プローブ光 L_p が偏光ビームスプリッター 104 により分岐され、P D 107 に入射した s_1 波の強度 S^2 と P D 106 に入射した p_1 波の強度 P^2 との差 V を求めることで、プローブ光 L_p の偏光面の回転角度 θ が正弦値として示される。回転角度 θ は磁場の強度に比例することから磁場の強度が導かれる。

【0056】

上述した磁場測定の原理では、レーザー光 L の照射方向に磁場方向が向いていることを前提としている。一方で、図 1 に示した磁場計測装置 100 は、ガスセル 102 を透過したプローブ光 L_p を反射するミラー 108 を備えている。ガスセル 102 を透過したプロ

50

ープ光 L_p はミラー 108 の法線に対して入射角 θ でミラー 108 に入射する。ミラー 108 で反射したプローブ光 L_p はミラー 108 の法線に対して反射角 θ で反射する。実際には、入射角 θ 及び反射角 θ が 3 度 ~ 10 度の範囲内となるように、各構成が配置されている。

したがって、本実施形態の磁場計測装置 100 においては、レーザー光 L の照射方向と磁場方向とが厳密には合致していないが、入射角 θ 及び反射角 θ が小さい角度となっているので、磁場計測装置 100 における磁場の受感方向をミラー 108 の法線方向（図 1 に矢印で示す方向）としている。

【0057】

微小な磁場の強度を測定可能な光ポンピング方式の磁場計測装置 100 は、地磁気や周辺環境から発する磁場などの外部磁場（外部磁場ノイズ）の影響を取り除いて磁場の測定を行うことが好ましい。本実施形態では、図 1 に示していないものの、磁場計測装置 100 は、外部磁場の影響を受け難くした磁気シールドルーム内に配置される。あるいは、磁場計測装置 100 のうち少なくともガスセル 102 が均一な磁場環境に配置される。均一な磁場環境を生じさせる手段として例えばヘルムホルツコイルなどが用いられ、外部磁場を打ち消す磁場を発生させたヘルムホルツコイルの中心にガスセル 102 を配置する方法が挙げられる。

【0058】

一方で、磁場の測定に影響を及ぼすのは外部磁場だけではない。例えば、レーザー光 L は、偏光保持光ファイバーを用いてレーザー発振器からレーザー光照射装置 101 の射出口に導かれて照射される。レーザー光 L には、偏光保持光ファイバーの振動や、レーザー光 L が照射された空間における空気の振動などによる直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズが含まれるおそれがある。とりわけ、偏光保持光ファイバーの振動を防止するために、偏光保持光ファイバーの筐体に対する固定を強化すると、固定された筐体からの振動を受け易くなったり、周囲の温度変化に影響されて膨張収縮し易くなったりして、新たな直線偏光回転ノイズを発生させてしまうという課題があった。

【0059】

本実施形態の磁場計測装置 100 は、上記光学ノイズの影響を低減するために、レーザー光 L をプローブ光 L_p と参照光 L_r とに分岐する無偏光ビームスプリッター 103 と、ガスセル 102 を透過した後のプローブ光 L_p の強度に対して参照光 L_r の強度を同等とするための光学フィルター 105 と、を備え、光学フィルター 105 を透過した後の参照光 L_r を偏光ビームスプリッター 104 に入射させて p_2 波と s_2 波とに分岐させ、 s_2 波を PD 106 に入射させ、 p_2 波を PD 107 に入射させる構成としている。以降、上記光学ノイズを低減する方法について、数式を示して具体的に説明する。

【0060】

ここでは、外部磁場（外部磁場ノイズ）の影響が取り除かれて、上記光学ノイズが存在する状態を前提として説明する。先に説明した磁場測定の原理において、図 3 に示したは、上記光学ノイズが存在する状態では、磁場源 M1 の磁場により偏光面が回転した回転角度（以降、本来の回転角度 θ と呼ぶ）と、レーザー光 L （プローブ光 L_p ）の直線偏光回転ノイズにより偏光面が回転した回転角度（以降、直線偏光回転ノイズの回転角度 θ と呼ぶ）とを含んでいることになる。回転角度 θ 及び回転角度 θ はそれぞれ回転方向に起因して +（プラス）と -（マイナス）とがある。したがって、回転方向を考慮すると、回転角度 θ 及び回転角度 θ の組み合わせは 4 つ存在する。

【0061】

本来の回転角度を +、直線偏光回転ノイズの回転角度を + とすると、図 3 に示したは、 $\theta = \theta + \theta$ となる。ガスセル 102 を透過した後のプローブ光 L_p の強度を W_1 とし、光学フィルター 105 を透過した後の参照光 L_r の強度を W_2 とすると、 $W_1 = W_2 = W$ となっている。したがって、これを磁場測定の原理における数式（4）、数式（5）に当てはめることで、偏光ビームスプリッター 104 のプローブ光 L_p の透過光（透過成分）である p_1 波の強度を P_1^2 とし、偏光ビームスプリッター 104 のプローブ光 L_p の反

10

20

30

40

50

射光（反射成分）である s_1 波の強度を S_1^2 とすると、 P_1^2 、 S_1^2 は、以下の数式（12）、数式（13）によって導かれる。

【0 0 6 2】

【数 1 2】

$$\left. \begin{aligned}
 P_1^2 &= \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} W \left[\cos(\alpha + \omega) - \sin(\alpha + \omega) \right] \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{2} W^2 \left[\cos^2(\alpha + \omega) - 2\cos(\alpha + \omega)\sin(\alpha + \omega) + \sin^2(\alpha + \omega) \right] \\
 &= \frac{1}{2} W^2 \left[1 - 2\cos(\alpha + \omega)\sin(\alpha + \omega) \right]
 \end{aligned} \right\} \cdots \quad (12) \quad 10$$

【0 0 6 3】

【数 1 3】

$$\left. \begin{aligned}
 S_1^2 &= \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} W \left[\cos(\alpha + \omega) + \sin(\alpha + \omega) \right] \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{2} W^2 \left[\cos^2(\alpha + \omega) + 2\cos(\alpha + \omega)\sin(\alpha + \omega) + \sin^2(\alpha + \omega) \right] \\
 &= \frac{1}{2} W^2 \left[1 + 2\cos(\alpha + \omega)\sin(\alpha + \omega) \right]
 \end{aligned} \right\} \cdots \quad (13) \quad 20$$

【0 0 6 4】

同じく、偏光ビームスプリッター 104 の参照光 L_r の透過光（透過成分）である p_2 波の強度を P_2^2 とし、偏光ビームスプリッター 104 の参照光 L_r の反射光（反射成分）である s_2 波の強度を S_2^2 とすると、 p_2 波及び s_2 波は磁場源 M1 の磁場の影響を受けず 30 に、直線偏光回転ノイズの影響を受けることから、 P_2^2 、 S_2^2 は、以下の数式（14）、数式（15）によって導かれる。

【0 0 6 5】

【数 1 4】

$$\left. \begin{aligned}
 P_2^2 &= \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos \omega - \sin \omega) \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{2} W^2 (\cos^2 \omega - 2\cos \omega \sin \omega + \sin^2 \omega) \\
 &= \frac{1}{2} W^2 (1 - 2\cos \omega \sin \omega)
 \end{aligned} \right\} \cdots \quad (14) \quad 40$$

【0 0 6 6】

【数15】

$$\begin{aligned}
 S_2^2 &= \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos \omega + \sin \omega) \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{2} W^2 (\cos^2 \omega + 2 \cos \omega \sin \omega + \sin^2 \omega) \\
 &= \frac{1}{2} W^2 (1 + 2 \cos \omega \sin \omega)
 \end{aligned}
 \quad \cdots \quad (15)$$

10

【0067】

図1に示すように、PD106には、p₁波とs₂波とが入射することから、PD106に入射する直線偏光の強度をP₃²とすると、P₃² = P₁² + S₂²となる。また、PD107には、s₁波とp₂波が入射することから、PD107に入射する直線偏光の強度をS₃²とすると、S₃² = S₁² + P₂²となる。すなわち、P₃²、S₃²は、以下の数式(16)、数式(17)によって導かれる。

【0068】

【数16】

$$P_3^2 = P_1^2 + S_2^2 = W^2 \left[1 - \cos(\alpha + \omega) \sin(\alpha + \omega) + \cos \omega \sin \omega \right] \quad \cdots \quad (16)$$

20

【0069】

【数17】

$$S_3^2 = P_2^2 + S_1^2 = W^2 \left[1 + \cos(\alpha + \omega) \sin(\alpha + \omega) - \cos \omega \sin \omega \right] \quad \cdots \quad (17)$$

30

【0070】

したがって、この場合のS₃²とP₃²との差をV₁とすると、V₁は以下の数式(18)によって導かれる。

【0071】

【数18】

$$\begin{aligned}
 V_1 &= S_3^2 - P_3^2 = 2W^2 \left\{ \cos(\alpha + \omega) \sin(\alpha + \omega) - \cos \omega \sin \omega \right\} \\
 &= 2W^2 \left\{ \frac{1}{2} \left[\sin(2\alpha + 2\omega) - \sin 2\omega \right] \right\} \\
 &= 2W^2 \left\{ \frac{1}{2} \left[\sin(2\alpha + 2\omega) + \sin(-2\omega) \right] \right\} \\
 &= 2W^2 \left\{ \frac{1}{2} \left[2 \sin \alpha \cos(\alpha + 2\omega) \right] \right\} \\
 &= 2W^2 \left\{ \sin \alpha \cos(\alpha + 2\omega) \right\}
 \end{aligned}
 \quad \cdots \quad (18)$$

40

【0072】

50

回転角度 α は、非常に小さな値である。したがって、上記式 (18) に

2 であることから、0 とすることがで
0 を当てはめると以下の式 (19) となる

。

【0073】
【数19】

$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 2W^2(\sin \alpha \cos \alpha) \\ &= W^2 \sin 2\alpha \end{aligned} \right\} \dots \quad (19)$$

10

【0074】

ガスセル 102 を透過しない参照光 L_r を偏光ビームスプリッター 104 に入射させて分岐し、分岐した s_2 波を PD106 へ入射させ、分岐した p_2 波を PD107 に入射させることで、PD106 と PD107 とに入射した直線偏光の強度の差 V_1 を求めると、 V_1 は本来の回転角度 α の正弦値として得られる。つまり、直線偏光回転ノイズの回転角度の影響が除かれ、本来の回転角度 α に基づく磁場の測定が可能となる。

【0075】

上記第1実施形態の磁場計測装置 100 は、レーザー光照射装置 101 から照射されたレーザー光 L をプローブ光 L_p と参照光 L_r とに分岐する無偏光ビームスプリッター 103 と、ガスセル 102 を透過したプローブ光 L_p の強度に対して参照光 L_r の強度を同等とする光学フィルター 105 とを備えている。このような磁場計測装置 100 によれば、ガスセル 102 を透過したプローブ光 L_p を偏光ビームスプリッター 104 に入射させて分岐し、分岐した p_1 波を PD106 へ入射させ、分岐した s_1 波を PD107 に入射させる。また、ガスセル 102 を透過しない参照光 L_r を偏光ビームスプリッター 104 に入射させて分岐し、分岐した s_2 波を PD106 へ入射させ、分岐した p_2 波を PD107 に入射させる。PD106 と PD107 とに入射した直線偏光の強度の差 V_1 を求めると、直線偏光であるプローブ光 L_p に直線偏光回転ノイズが含まれていても、 V_1 は本来の回転角度 α の正弦値として得られる。つまり、直線偏光回転ノイズの回転角度 α の影響が除かれ、本来の回転角度 α に基づく磁場の測定が可能となり、直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズを低減して、精度よく磁場源 M1 の磁場を測定することができる。

20

30

【0076】

(第2実施形態)

次に、第2実施形態の磁場計測装置について、図4を参照して説明する。図4は第2実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図である。第2実施形態の磁場計測装置は、上記第1実施形態の磁場計測装置 100 に対して、プローブ光 L_p がガスセル 102 を1回透過した後に、第2光学手段である偏光ビームスプリッター 104 に入射する構成としたものである。したがって、上記第1実施形態の磁場計測装置 100 と同じ構成には同じ符号を付して詳細な説明は省略する。

【0077】

図4に示すように、本実施形態の磁場計測装置 150 は、直線偏光を照射する光照射手段としてのレーザー光照射装置 101 と、ガスセル 102 と、第1光学手段としての無偏光ビームスプリッター 103 と、第2光学手段としての偏光ビームスプリッター 104 と、第3光学手段としての光学フィルター 105 と、第1検出部としての PD106 と、第2検出部としての PD107 と、2つの非磁性のミラー 151, 152 と、を備えている。

40

【0078】

レーザー光照射装置 101 と磁場源 M1 とを結ぶ光軸上(直線上)に、無偏光ビームスプリッター 103、ガスセル 102、偏光ビームスプリッター 104 がこの順で並ぶように配置されている。

【0079】

50

レーザー光照射装置 101 から照射されたレーザー光 L は、無偏光ビームスプリッター 103 のプリズム界面 103a に入射し、光軸に沿って無偏光ビームスプリッター 103 を透過するプローブ光 L_p と、プリズム界面 103a で光軸に対して直交する方向に反射する参照光 L_r とに分岐される。

【0080】

無偏光ビームスプリッター 103 を透過したプローブ光 L_p は、ガスセル 102 に入射し、ガスセル 102 を 1 回透過した後に、偏光ビームスプリッター 104 の第 1 面 104a に入射する。一方、無偏光ビームスプリッター 103 で反射した参照光 L_r は、光学フィルター 105 を透過した後に、ミラー 151 とミラー 152 とによって反射して、偏光ビームスプリッター 104 の第 2 面 104b に入射する。

10

【0081】

第 1 面 104a からプリズム界面 104c に入射した直線偏光であるプローブ光 L_p は、偏光ビームスプリッター 104 を光軸に沿って透過する p_1 波と、プリズム界面 104c で反射する s_1 波とに分岐される。 p_1 波は、光軸に沿って進行して PD106 に入射する。 s_1 波は、プリズム界面 104c で光軸に対して直交する方向に反射して PD107 に入射する。

【0082】

第 2 面 104b からプリズム界面 104c に入射した直線偏光である参照光 L_r は、光軸に対して直交する方向に偏光ビームスプリッター 104 を透過する p_2 波と、プリズム界面 104c で光軸に沿った方向に反射する s_2 波とに分岐される。 p_2 波は、光軸に直交する方向に沿って進行して PD107 に入射する。 s_2 波は、プリズム界面 104c で光軸に沿った方向に反射して PD106 に入射する。すなわち、PD106 には、 p_1 波と s_2 波とが入射し、PD107 には s_1 波と p_2 波とが入射する。

20

【0083】

本実施形態の磁場計測装置 150 では、ガスセル 102 に対するレーザー光 L の照射方向と、磁場源 M1 の磁場方向とが合致しており、上述した磁場測定の原理を的確に当てはめることができる。また、ガスセル 102 を透過しない参照光 L_r を偏光ビームスプリッター 104 の第 2 面 104b から入射させて p_2 波と s_2 波とに分岐させて、 s_2 波を PD106 に入射させ、 p_2 波を PD107 に入射させる。したがって、上記第 1 実施形態と同様に、プローブ光 L_p に含まれる直線偏光回転ノイズを除いて、本来のプローブ光 L_p の回転角度に基づいて、磁場源 M1 の磁場強度を精度よく測定することができる。なお、偏光ビームスプリッター 104 に入射する参照光 L_r の強度は、参照光 L_r が光学フィルター 105 を透過することで、ガスセル 102 を透過した後に偏光ビームスプリッター 104 に入射するプローブ光 L_p の強度と同等となるように調整される。

30

【0084】

上記第 1 実施形態の磁場計測装置 100 では、プローブ光 L_p がガスセル 102 を少なくとも 2 回透過する構成とすることで、本実施形態の磁場計測装置 150 よりも高感度に磁場源 M1 の磁場強度を測定可能である。一方で、上記第 1 実施形態の磁場計測装置 100 において、無偏光ビームスプリッター 103 により分岐された参照光 L_r を的確に偏光ビームスプリッター 104 の第 2 面 104b に入射させるには、無偏光ビームスプリッター 103 と偏光ビームスプリッター 104 との相対的な位置を精度よく調整する必要がある。これに対して、本実施形態の磁場計測装置 150 は、ガスセル 102 を挟んで無偏光ビームスプリッター 103 と偏光ビームスプリッター 104 とを直線上に配置すればよいことから、相対的な位置の調整が容易である。

40

【0085】

上記第 1 実施形態の磁場計測装置 100 は、ガスセル 102 に対して、磁場源 M1 を近くに配置することができる点において、磁場強度の測定上、本実施形態の磁場計測装置 150 よりも優れている。本実施形態の磁場計測装置 150 では、ガスセル 102 と磁場源 M1 との間に、偏光ビームスプリッター 104 と、PD106 とが配置されることから、磁場強度の測定に影響を及ぼさないように、PD106 は非磁性であることが好ましい。

50

【0086】

また、本実施形態の磁場計測装置150において、光学フィルターの符号は、上記第1実施形態の磁場計測装置100と同じ符号105を用いたが、実際には、上記第1実施形態の磁場計測装置100では、プローブ光Lpがガスセル102を少なくとも2回透過することから、ガスセル102を透過した後のプローブ光Lpの強度は、本実施形態の磁場計測装置150に比べて上記第1実施形態の磁場計測装置100の方が低下する。したがって、第2光学手段としての偏光ビームスプリッター104にプローブ光Lpと参照光Lrとを強度が同等な状態で入射させるには、第3光学手段としての光学フィルター105は、光の透過率を変化させることができ構成であることが好ましい。

【0087】

10

(第3実施形態)

次に、第3実施形態の磁場計測装置について、図5を参照して説明する。図5は第3実施形態の磁場計測装置の構成を示す概略図である。第3実施形態の磁場計測装置は、上記第1実施形態の磁場計測装置100と同じ構成を有するものであるが、無偏光ビームスプリッター103と偏光ビームスプリッター104との相対的な位置関係を異ならせたものである。したがって、上記第1実施形態の磁場計測装置100と同じ構成には同じ符号を付して、詳細な説明は省略する。

【0088】

20

図5に示すように、本実施形態の磁場計測装置100Bは、直線偏光を照射する光照射手段としてのレーザー光照射装置101と、ガスセル102と、第1光学手段としての無偏光ビームスプリッター103と、第2光学手段としての偏光ビームスプリッター104と、第3光学手段としての光学フィルター105と、入射した光の強度を検出する第1検出部としてのフォトディテクタ(PD)106と、同じく入射した光の強度を検出する第2検出部としてのフォトディテクタ(PD)107と、ミラー108と、を備えている。

【0089】

30

レーザー光照射装置101から照射され、無偏光ビームスプリッター103に入射したレーザー光Lは、プローブ光Lpと参照光Lrとに分岐される。無偏光ビームスプリッター103を透過したプローブ光Lpは、受感方向に対し入射角度でガスセル102に入射する。磁場源M1とガスセル102との間にミラー108が配置されていることから、ガスセル102を透過したプローブ光Lpは、ミラー108によって反射され、再びガスセル102に入射する。すなわち、プローブ光Lpは、ガスセル102を2回透過する。

【0090】

ガスセル102を2回透過したプローブ光Lpは、偏光ビームスプリッター104に入射する。偏光ビームスプリッター104に入射したプローブ光Lpは、p₁波とs₁波とに分岐され、p₁波は偏光ビームスプリッター104を透過してPD106に入射する。s₁波は偏光ビームスプリッター104のプリズム界面104cで反射されてPD107に入射する。

【0091】

40

一方、無偏光ビームスプリッター103のプリズム界面103aで反射した参照光Lrは、光学フィルター105を透過した後に、偏光ビームスプリッター104の第2面104bに入射する。光学フィルター105を透過した参照光Lrの強度W₂は、偏光ビームスプリッター104の第1面104aに入射する直前のプローブ光Lpの強度W₁とほぼ同等となっている。

【0092】

偏光ビームスプリッター104に入射した参照光Lrは、偏光ビームスプリッター104を透過するp₂波と、偏光ビームスプリッター104のプリズム界面104cで反射したs₂波とに分岐される。p₂波はPD107に入射し、s₂波はPD106に入射する。

【0093】

50

本実施形態では、PD106に入射するp₁波の光軸とs₂波の光軸とが同じであると共に

に、 p_1 波の位相と s_2 波の位相とが同じになっている。また、PD107に入射する p_2 波の光軸と s_1 波の光軸とが同じであると共に、 p_2 波の位相と s_1 波の位相とが同じになっている。言い換えれば、PD106に入射する p_1 波と s_2 波とにおいて、その光軸と位相とが同じになるように、またPD107に入射する p_2 波と s_1 波とにおいて、その光軸と位相とが同じになるように、無偏光ビームスプリッター103と偏光ビームスプリッタ-104とがレーザー光L（プローブ光Lp）の光軸上に配置されている。

【0094】

次に、このような磁場計測装置100Bにおけるレーザー光Lが照射された空間の空気の振動などによる直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズの低減方法について、数式(20)～数式(27)を参照して説明する。

10

【0095】

上記第1実施形態で説明したように、磁場測定における本来の回転角度をとし、直線偏光回転ノイズの回転角度をとすると、図3に示したは $= +$ となる。これを上記第1実施形態で説明した磁場測定の原理における数式(6)、数式(7)に当てはめると、 p_1 波の振幅 P_1 、 s_1 波の振幅 S_1 、 p_2 波の振幅 P_2 、 s_2 波の振幅 S_2 は、以下の数式(20)～数式(23)によって導かれる。

【0096】

【数20】

$$P_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos(\alpha + \omega) - \sin(\alpha + \omega)) \quad \dots \quad (20)$$

20

【0097】

【数21】

$$S_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos(\alpha + \omega) + \sin(\alpha + \omega)) \quad \dots \quad (21)$$

【0098】

【数22】

30

$$P_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos \omega - \sin \omega) \quad \dots \quad (22)$$

【0099】

【数23】

$$S_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos \omega + \sin \omega) \quad \dots \quad (23)$$

40

【0100】

PD106に入射した直線偏光の振幅 P_4 は、 $P_4 = P_1 + S_2$ であり、PD107に入射した直線偏光の振幅 S_4 は、 $S_4 = S_1 + P_2$ であることから、 P_4 、 S_4 は以下の数式(24)、数式(25)で導かれる。

【0101】

【数24】

$$P_4 = P_1 + S_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos(\alpha + \omega) - \sin(\alpha + \omega) + \cos \omega + \sin \omega) \quad \dots \quad (24)$$

50

【 0 1 0 2 】

【数 2 5 】

$$S_4 = S_1 + P_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} W (\cos(\alpha + \omega) + \sin(\alpha + \omega) + \cos \omega - \sin \omega) \quad \dots \quad (25)$$

【 0 1 0 3 】

この場合の P D 1 0 7 に入射した直線偏光の強度である S_4^2 と、 P D 1 0 6 に入射した直線偏光の強度である P_4^2 との差を U_1 とすると、 U_1 は、以下の数式 (2 6) で導かれる。

10

【 0 1 0 4 】

【数 2 6 】

$$\begin{aligned} U_1 &= S_4^2 - P_4^2 \\ &= 2W^2 \left[\sin(\alpha + \omega) \cos(\alpha + \omega) + \sin(\alpha + \omega) \cos \omega \right. \\ &\quad \left. - \sin \omega \cos(\alpha + \omega) - \sin \omega \cos \omega \right] \\ &= 2W^2 \left[\sin(\alpha + \omega) - \sin \omega \right] \left[\cos(\alpha + \omega) + \cos \omega \right] \\ &= 8W^2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \left(\frac{\alpha + 2\omega}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + 2\omega}{2} \right) \cos \frac{\alpha}{2} \\ &= 2W^2 \sin \alpha \cos^2 \left(\frac{\alpha + 2\omega}{2} \right) \end{aligned} \quad \dots \quad (26) \quad 20$$

【 0 1 0 5 】

上記第 1 実施形態において説明したように、本来の回転角度 α と直線偏光回転ノイズの回転角度 ω との関係は、 $\alpha = 2\omega$ であり、且つ、 ω の値も極小さいものとして $\omega \ll \alpha$ として近似することが可能であることから、数式 (2 6) に $\alpha = 2\omega$ を適用すると、以下の数式 (2 7) が導かれる。

30

【 0 1 0 6 】

【数 2 7 】

$$U_1 = 2 W^2 \sin \alpha \quad \dots \quad (27)$$

【 0 1 0 7 】

数式 (2 7) に示すように、本来の回転角度を α とし、直線偏光回転ノイズの回転角度を ω とすると、 U_1 は回転角度 α の正弦値として得られる。つまり、直線偏光回転ノイズに係る回転角度 ω の影響を除いて、本来の回転角度 α に基づく磁場の測定が可能となる。

40

【 0 1 0 8 】

直線偏光回転ノイズに係る回転角度 ω の影響が除かれることから、回転角度 α の回転方向 (\pm) は無視できる。また、本来の回転角度 α の回転方向 (\pm) に関わらず磁場の測定が可能である。

【 0 1 0 9 】

上記第 3 実施形態の磁場計測装置 1 0 0 B は、レーザー光照射装置 1 0 1 から照射されたレーザー光 L をプローブ光 L_p と参照光 L_r とに分岐する無偏光ビームスプリッター 1 0 3 と、ガスセル 1 0 2 を透過したプローブ光 L_p の強度に対して参照光 L_r の強度を同

50

等とする光学フィルター 105とを備えている。このような磁場計測装置 100Bによれば、ガスセル 102を透過したプローブ光 Lpを偏光ビームスプリッター 104に入射させて分岐し、分岐したp₁波を PD106へ入射させ、分岐したs₁波を PD107に入射させる。また、ガスセル 102を透過しない参照光 Lrを偏光ビームスプリッター 104に入射させて分岐し、分岐したs₂波を PD106へ入射させ、分岐したp₂波を PD107に入射させる。また、PD106に入射するp₁波とs₂波とにおいて、その光軸と位相とが同じになるように、また、PD107に入射するp₂波とs₁波とにおいて、その光軸と位相とが同じになるように、無偏光ビームスプリッター 103と偏光ビームスプリッター 104とがレーザー光 L (プローブ光 Lp)の光軸上に配置されている。したがって、PD106とPD107とに入射した直線偏光の強度の差U₁を求めるとき、直線偏光であるプローブ光 Lpに直線偏光回転ノイズが含まれていても、U₁は本来の回転角度の正弦値として表される。つまり、直線偏光回転ノイズの回転角度の影響が除かれて、本来の回転角度に基づく磁場の測定が可能となる。すなわち、直線偏光回転ノイズを含む光学ノイズを低減して、精度よく磁場源 M1の磁場を測定することができる。

10

【0110】

本発明は、上記した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う磁場計測装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。上記実施形態以外にも様々な変形例が考えられる。以下、変形例を挙げて説明する。

20

【0111】

(変形例 1) 上記第 2 実施形態の磁場計測装置 150において、非磁性のミラー 151, 152の配置は、これに限定されない。図 6 は変形例の磁場計測装置の構成を示す概略図である。例えば、図 6 に示す変形例の磁場計測装置 150Bは、上記第 2 実施形態の磁場計測装置 150に対して、1つの非磁性のミラー 151を用いた例を示すものである。具体的には、磁場計測装置 150Bは、レーザー光照射装置 101と、ガスセル 102と、無偏光ビームスプリッター 103と、偏光ビームスプリッター 104と、光学フィルター 105と、PD106と、PD107と、1つの非磁性のミラー 151と、を備えている。レーザー光 L は無偏光ビームスプリッター 103によってプローブ光 Lpと参照光 Lrとに分岐される。分岐された参照光 Lrは光学フィルター 105を透過した後に、ミラー 151で反射して、偏光ビームスプリッター 104の第 2 面 104bに入射する構成となっている。つまり、分岐された参照光 Lrがミラー 151に入射するように、レーザー光照射装置 101とガスセル 102との間の光軸上におけるプリズム界面 103aの向きが設定されるよう無偏光ビームスプリッター 103を回転させている。変形例の磁場計測装置 150Bでは、1つのミラー 151を用いているので、複数のミラーを用いる場合に比べて装置構成が簡素化される。なお、非磁性のミラーの数は、1つあるいは2つに限定されず、3つ以上のミラーを用いて参照光 Lrを第 2 面 104bに導いてもよい。

30

【0112】

(変形例 2) 上記各実施形態の磁場計測装置において、第 2 光学手段である偏光ビームスプリッター 104にプローブ光 Lpと参照光 Lrとを入射させる光学手段は、非磁性のミラーに限定されない。プローブ光 Lp、参照光 Lrのそれぞれの光路に例えばプリズムを挿入して、第 1 面 104aにプローブ光 Lpを入射させ、第 2 面 104bに参照光 Lrを入射させてもよい。

40

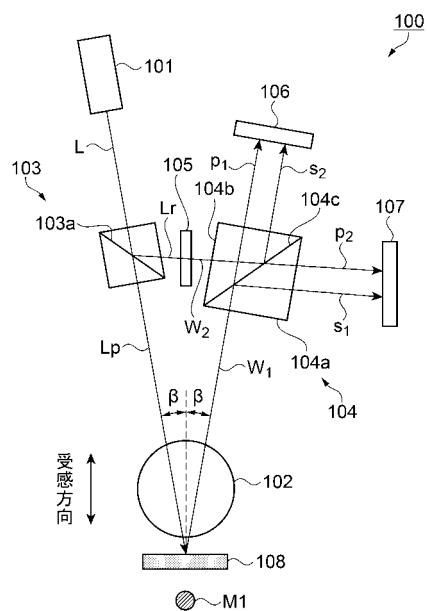
【符号の説明】

【0113】

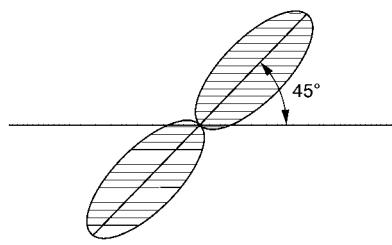
100, 150...磁場計測装置、101...光照射手段としてのレーザー光照射装置、102...ガスセル、103...第 1 光学手段としての無偏光ビームスプリッター、104...第 2 光学手段としての偏光ビームスプリッター、104a...第 1 面、104b...第 2 面、105...第 3 光学手段としての光学フィルター、106...第 1 検出部としてのフォトディテクタ (PD)、107...第 2 検出部としてのフォトディテクタ (PD)、108, 151, 152...非磁性のミラー、Lp...プローブ光、Lr...参照光、M1...磁場源。

50

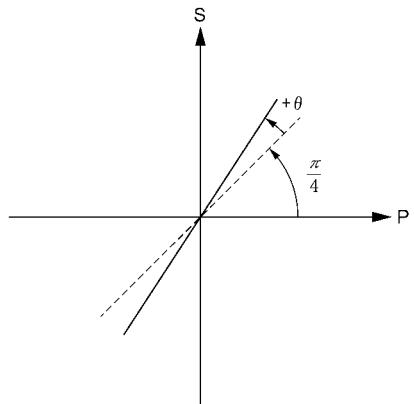
【図1】



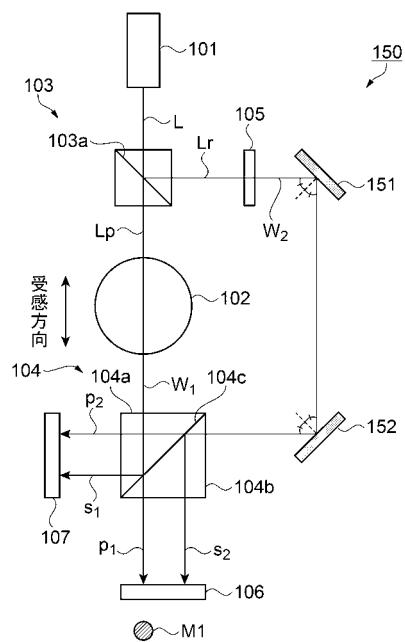
【図2】



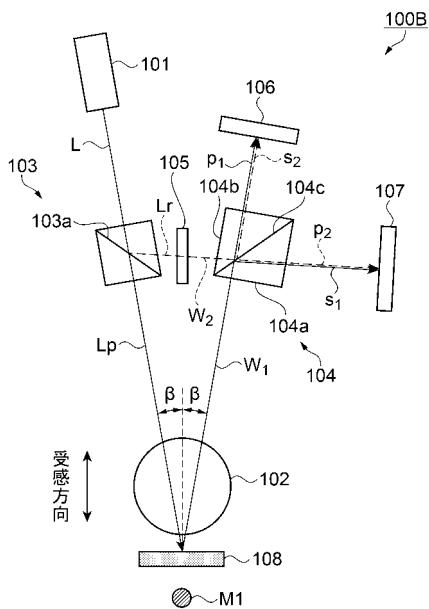
【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

